

# Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation

NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

## GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 2 - 4 GHz

### Typical Applications

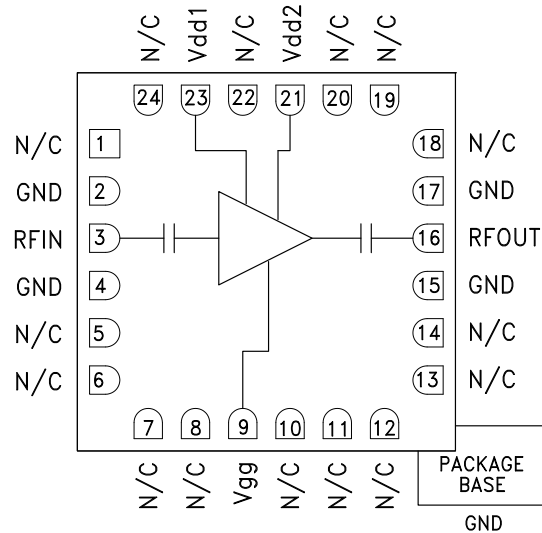
The HMC609LC4 is ideal for:

- Fixed Microwave
- Test & Measurement Equipment
- Radar & Sensors
- Military & Space

### Features

- Excellent Gain Flatness:  $\pm 0.4$  dB
- High Gain: 20 dB
- Low Noise Figure: 3.5 dBm
- Output IP3: +36.5 dBm
- 50 Ohm Matched & DC Blocked RF I/Os
- RoHS Compliant 4 x 4 mm SMT Package

### Functional Diagram



### General Description

The HMC609LC4 is a GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which operates from 2 to 4 GHz. The HMC609LC4 features extremely flat performance characteristics including 20 dB of small signal gain, 3.5 dB of noise figure and output IP3 of +36.5 dBm across the operating band. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external matching components. The HMC609LC4 is compatible with high volume surface mount manufacturing techniques, and the RF I/Os are DC blocked for further ease of integration.

### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$ , $V_{dd1} = V_{dd2} = +6\text{V}$ , $I_{dd1} + I_{dd2} = 170 \text{mA}$ [1]

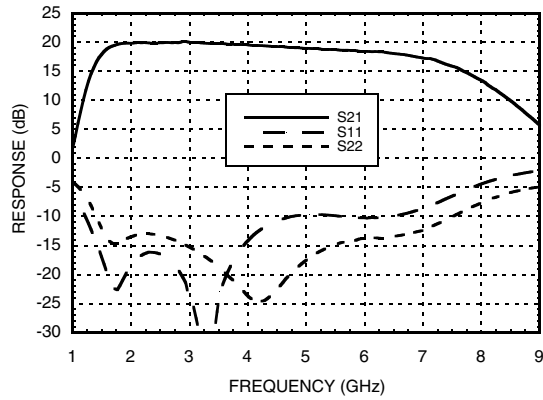
Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	2 - 4			GHz
Gain	17	20		dB
Gain Variation Over Temperature		0.015	0.02	dB/°C
Noise Figure		3.5	5.5	dB
Input Return Loss		17		dB
Output Return Loss		15		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	18.5	21.5		dBm
Saturated Output Power (P <sub>sat</sub> )		23		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		36.5		dBm
Supply Current (I <sub>dd1</sub> + I <sub>dd2</sub> )		170	220	mA

Adjust V<sub>gg</sub> between -1.5V to -0.5V (Typical -0.9V) to achieve total drain bias of 170mA

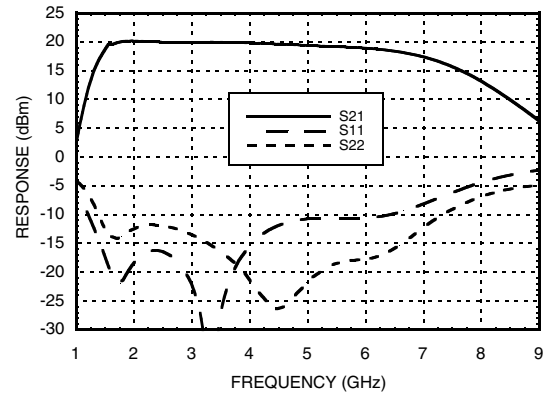


**GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE  
AMPLIFIER, 2 - 4 GHz**

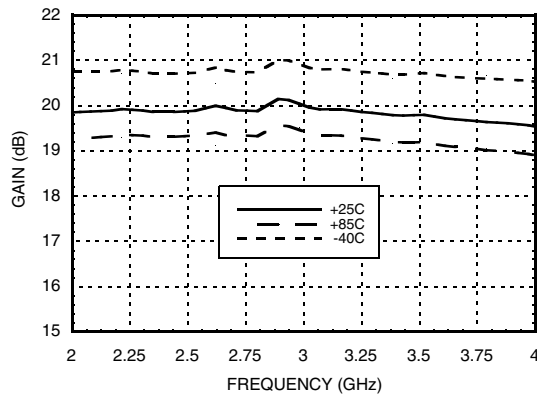
**Broadband Gain & Return Loss<sup>[1]</sup>**



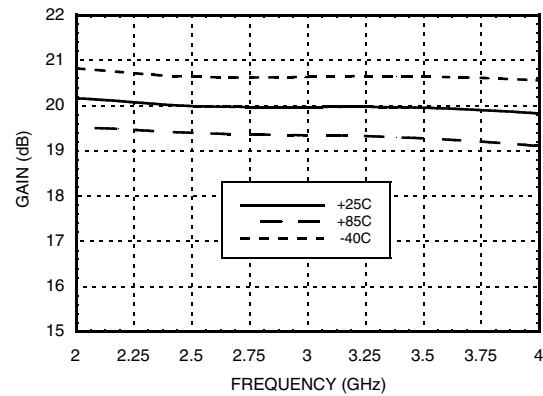
**Broadband Gain & Return Loss<sup>[2]</sup>**



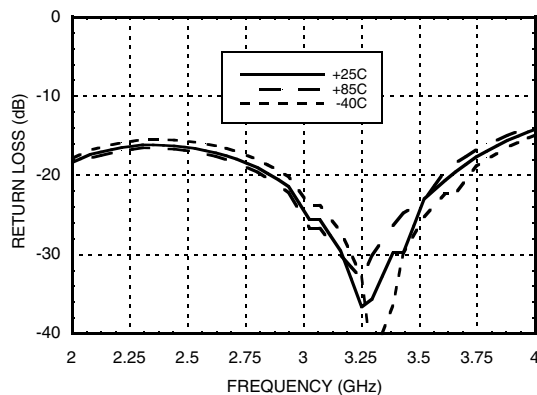
**Gain vs. Temperature<sup>[1]</sup>**



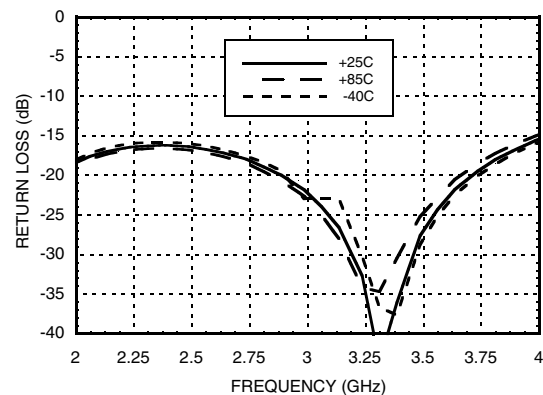
**Gain vs. Temperature<sup>[2]</sup>**



**Input Return Loss vs. Temperature<sup>[1]</sup>**



**Input Return Loss vs. Temperature<sup>[2]</sup>**

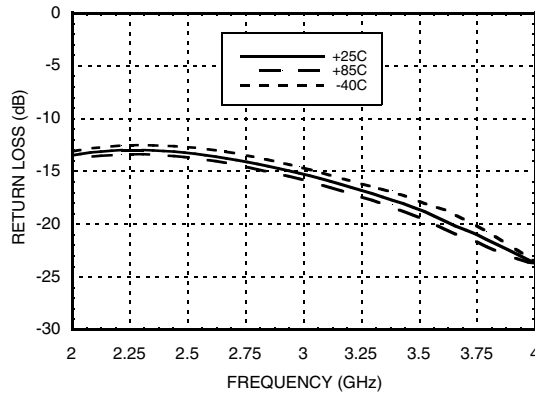


[1] Vdd = 6V      [2] Vdd = 5V

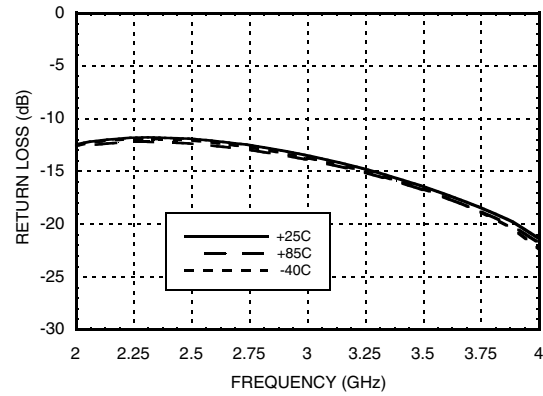
## GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 2 - 4 GHz

AMPLIFIERS - LOW NOISE- SMT

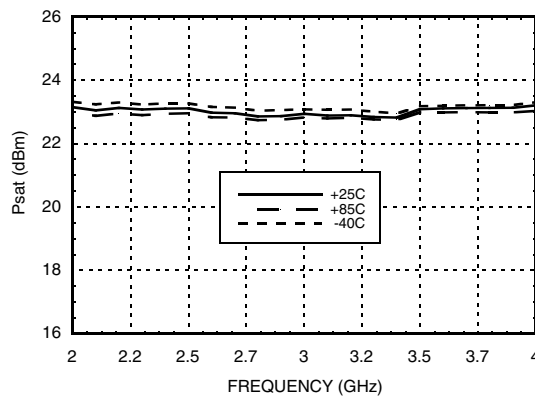
**Output Return Loss vs. Temperature [1]**



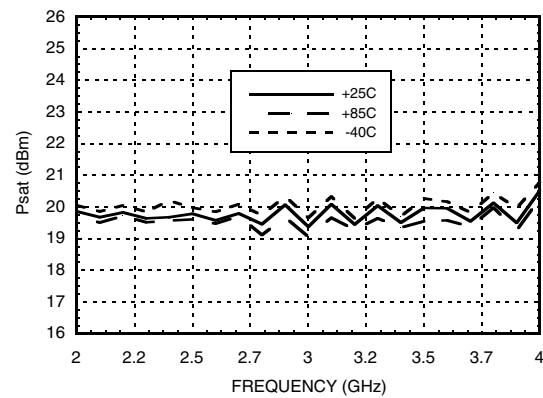
**Output Return Loss vs. Temperature [2]**



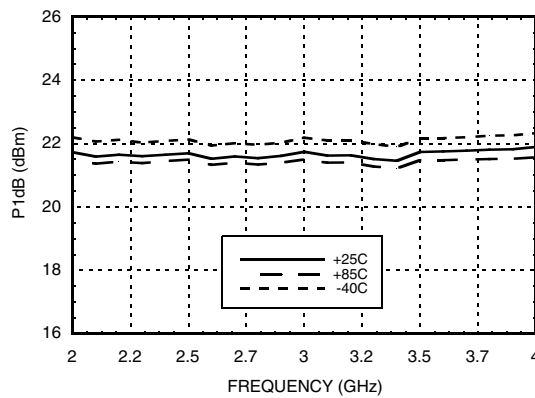
**Psat vs. Temperature [1]**



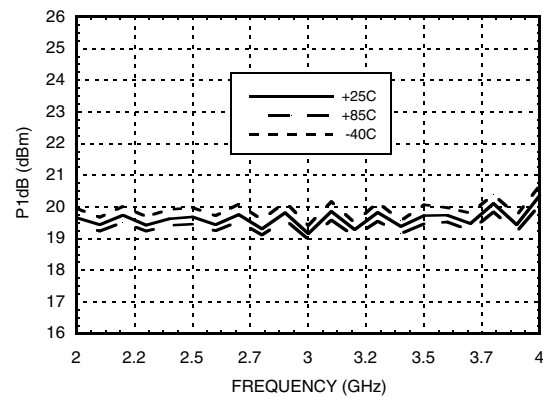
**Psat vs. Temperature [2]**



**P1dB vs. Temperature [1]**



**P1dB vs. Temperature [2]**



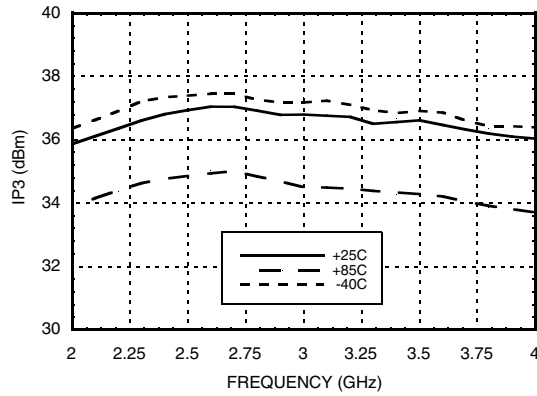
[1] Vdd = 6V

[2] Vdd = 5V

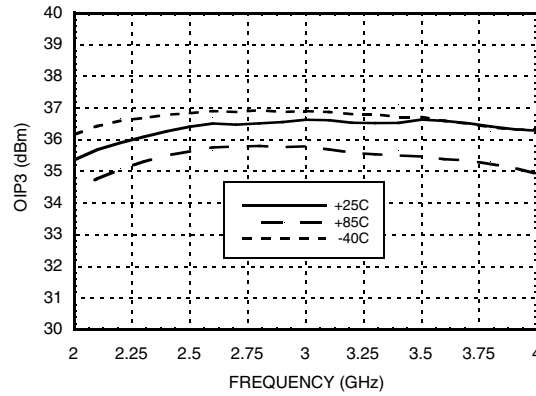


**GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE  
AMPLIFIER, 2 - 4 GHz**

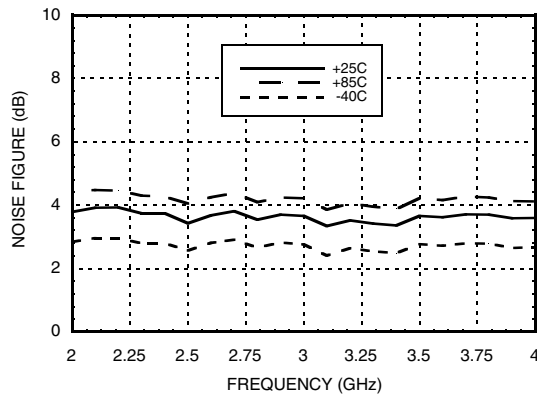
**Output IP3 vs. Temperature [1]**



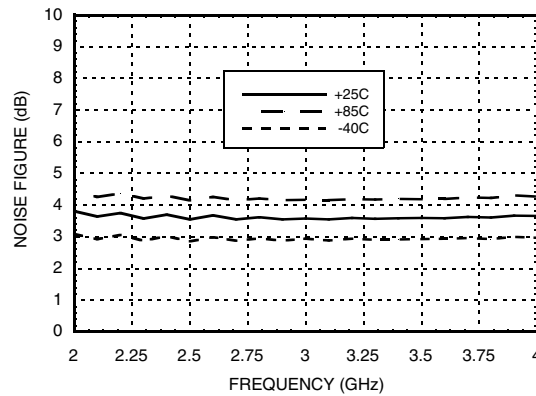
**Output IP3 vs. Temperature [2]**



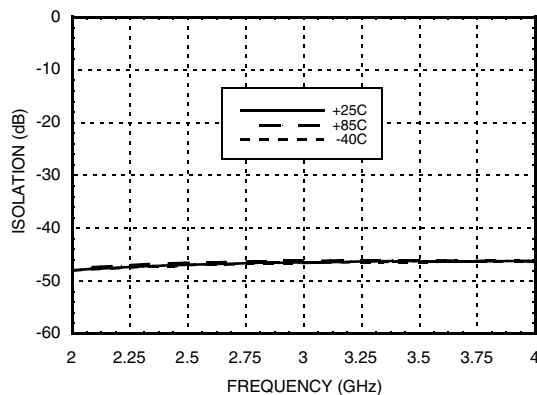
**Noise Figure vs. Temperature [1]**



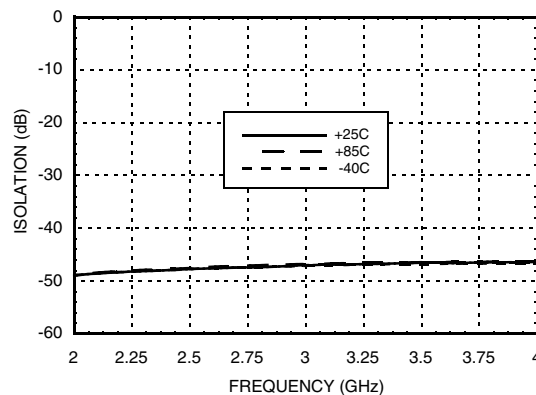
**Noise Figure vs. Temperature [2]**



**Reverse Isolation vs. Temperature [1]**



**Reverse Isolation vs. Temperature [2]**



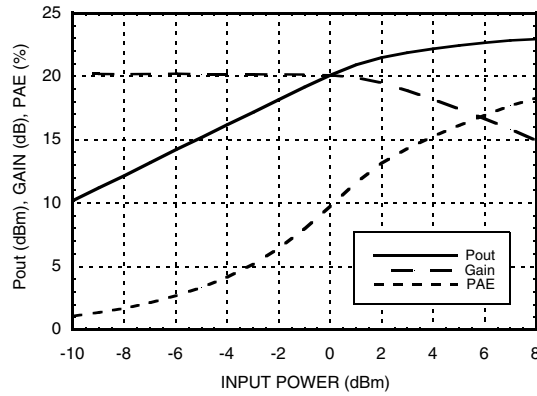
[1] Vdd = 6V

[2] Vdd = 5V



## GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 2 - 4 GHz

**Power Compression @ 3 GHz**



### Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage (Vdd)	7 Vdc
RF Input Power (RFIN)(Vdd = +6.0 Vdc)	+15 dBm
Channel Temperature	175 °C
Continuous Pdiss (T= 85 °C) (derate 16.7 mW/°C above 85 °C)	1.1 W
Thermal Resistance (channel to ground paddle)	60 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C

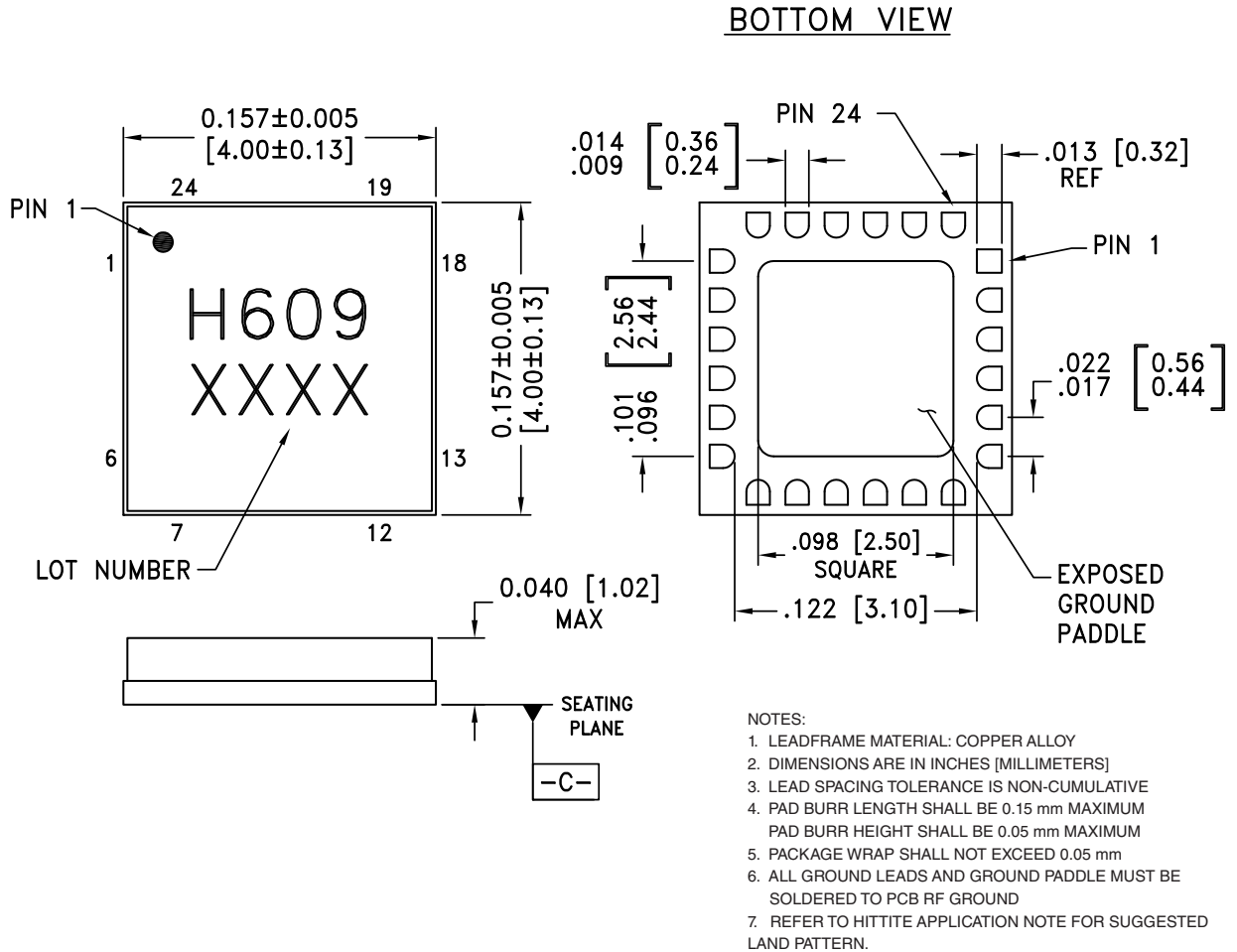
### Typical Supply Current vs. Vdd

Vdd (V)	Idd (mA)
+5.5	160
+6.0	170
+6.5	180

Note: Amplifier will operate over full voltage range shown above



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

**Outline Drawing**

**Package Information**

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking <sup>[2]</sup>
HMC609LC4	Alumina, White	Gold over Nickel	MSL3 <sup>[1]</sup>	H609 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 260 °C

[2] 4-Digit lot number XXXX





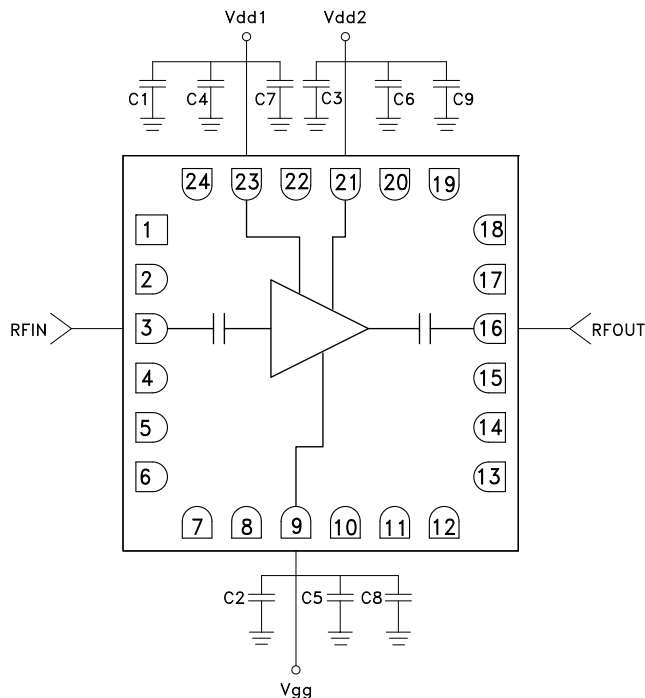
## GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 2 - 4 GHz

### Pin Descriptions

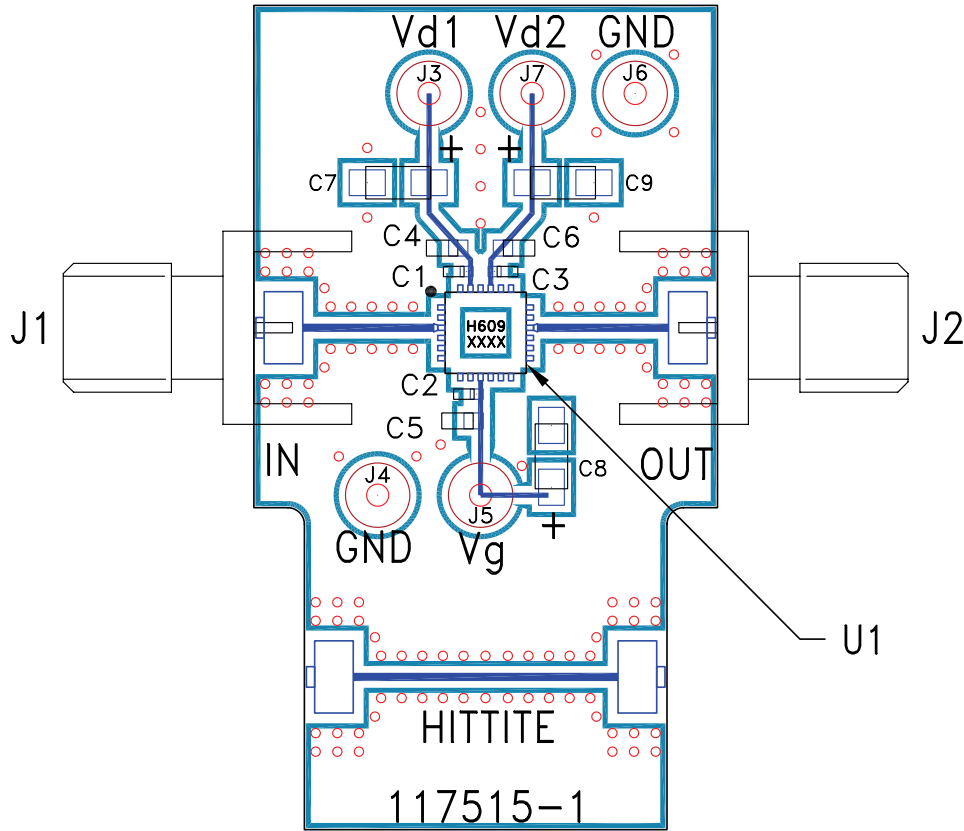
Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 5 - 8, 10 - 24, 18 - 20, 22, 24	N/C	This pin may be connected to RF/DC ground. Performance will not be affected.	
2, 4, 15, 17	GND	These pins and package bottom must also be connected to RF/DC ground.	
3	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
9	Vgg	Gate supply voltage for the amplifier. (External bypass capacitors are required.)	
16	RFOUT	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
21, 23	Vdd1, Vdd2	Power Supply Voltage for the amplifier. (External bypass capacitors are required.).	

### Application Circuit

Component	Value
C1 - C3	100 pF
C4 - C6	1,000 pF
C7 - C9	2.2 μF



### Evaluation PCB



### List of Materials for Evaluation PCB 117510 [1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA Connector
J3 - J7	DC Pin
C1 - C3	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C4 - C6	1000pF Capacitor, 0603 Pkg.
C7 - C9	2.2 μF Capacitor, Tantalum
U1	HMC609LC4 Amplifier
PCB [2]	1117515 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А